This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- · FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 33/00, H01S 3/19

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

IT, LU, MC, NL, PT, SE).

WO 97/50132

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE,

31. Dezember 1997 (31.12.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/01337

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. Juni 1997 (26.06.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 25 622.4 196 38 667.5 26. Juni 1996 (26.06.96)

DE 20. September 1996 (20.09.96) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): REEH, Ulrike [DE/DE]; Hollerstrasse 7A, D-80995 München (DE). HÖHN, Klaus [DE/DE]; Pater-Rupert-Mayer-Weg 5, D-82024 Taufkirchen (DE). STATH, Norbert [DE/DE]; Rosinusweg 11, D-93049 Regensburg (DE). WAITL, Günther [DE/DE], Praschweg 3, D-93049 Regensburg (DE). SCHLOTTER, Peter [DE/DE]: Kammertalstrasse 8A, D-79113 Freiburg (DE). SCHMIDT, Rolf [DE/DE]; Mühlenstrasse 14, D-79279 Vörstetten (DE). SCHNEIDER, Jürgen [DE/DE]; Neuhäuser Strasse 62, D-79199 Kirchzarten (DE).

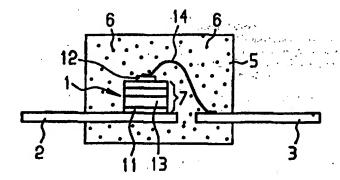
Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR COMPONENT WITH LUMINESCENCE CONVERSION ELEMENT

(54) Bezeichnung: LICHTABSTRAHLENDES HALBLEITERBAUELEMENT MIT LUMINESZENZKONVERSIONSELEMENT



(57) Abstract

Light-emitting semiconductor component with a radiation-emitting semiconductor body (1) and a luminescence conversion element (4, 5). The semiconductor body (1) emits radiation in the ultraviolet, blue and/or green region of the spectrum, and the luminescence conversion element (4, 5) converts a part of this radiation into radiation of a greater wavelength. This enables light-emitting diodes which emit mixed-colour, in particular white, light by means of a single light-emitting semiconductor body to be produced. The specially preferred luminescence conversion dye is YAG:Ce.

(57) Zusammenfassung

Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement mit einem Strahlung aussendenden Halbleiterkörper (1) und einem Lumineszenzkonversionselement (4, 5). Der Halbleiterkörper (1) sendet Strahlung im ultravloletten, blauen und/oder grünen Spektralbereich aus und das Lumineszenzkonversionselement (4, 5) wandelt einen Teil dieser Strahlung im Strahlung mit einer größeren Wellenlänge um. Dadurch lassen sich Leuchtdioden herstellen, die mittels eines einzigen lichtaussendenden Halbleiterkörpers mischfarbiges Licht, insbesondere weißes Licht abstrahlen. Besonders bevorzugt wird als Lumineszenzkonversionsfarbstoff YAG:Ce verwendet.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS.	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litanen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB .	Vereinigtes Königreich	MC ·	Monaco	TD	Techad .
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar .	TJ	Tadachikistan
BE	Belgien	GŃ	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Paso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgishtan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
a	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen · · ·		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachatan	RO	Ruminien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	u	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
RE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

1

Beschreibung

Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement mit Lumineszenzkonversionselement

5

10

15

20

Die Erfindung bezieht sich auf ein lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Ein derartiges Halbleiterbauelement ist beispielsweise aus der Offenlegungsschrift DE 38 04 293 bekannt. Darin ist eine Anordnung mit einer Elektrolumineszenz- oder Laserdiode beschrieben, bei der das gesamte von der Diode abgestrahlte Emmissionsspektrum mittels eines mit einem fluoreszierenden, lichtwandelnden organischen Farbstoff versetzten Elements aus Kunststoff zu größeren Wellenlängen hin verschoben wird. Das von der Anordnung abgestrahlte Licht weist dadurch eine andere Farbe auf als das von der Leuchtdiode ausgesandte. Abhängig von der Art des dem Kunststoff beigefügten Farbstoffes lassen sich mit ein und demselben Leuchtdiodentyp Leuchtdiodenanordnungen herstellen, die in unterschiedlichen Farben leuchten.

Aus DE-OS 2 347 289 ist eine Infrarot(IR)-Festkörperlampe bekannt, bei der an der Kante einer IR-Diode Leuchtstoff-Material angebracht ist, das die dort abgestrahlte IR-Strahlung in sichtbares Licht umwandelt. Ziel dieser Maßnahme ist es, zu Kontrollzwecken einen möglichst geringen Teil der von der Diode abgegebenen IR-Strahlung bei gleichzeitig möglichst geringer Verminderung der Intensität der abgegebenen IR-Strahlung in sichtbares Licht umzuwandeln.

30

25

Weiterhin ist aus der EP 486 052 eine lichtemittierende Diode bekannt, bei der zwischen dem Substrat und einer aktiven elektrolumineszierenden Schicht mindestens eine Halbleiter-Photolumineszenzschicht angeordnet ist, die das von der aktiven Schicht in Richtung Substrat ausgesandte Licht eines ersten

. 2

Wellenlängenbereichs in Licht eines zweiten Wellenlängenbereichs umwandelt, so daß die lichtemittierende Diode insgesamt Licht verschiedener Wellenlängenbereiche aussendet.

In vielen potentiellen Anwendungsgebieten für Leuchtdioden, wie zum Beispiel bei Anzeigeelementen im Kfz-Armaturenbrett, Beleuchtung in Flugzeugen und Autos und bei vollfarbtauglichen LED-Displays, tritt verstärkt die Forderung nach Leuchtdiodenanordnungen auf, mit denen sich mischfarbiges Licht, insbesondere weißes Licht erzeugen läßt.

In JP-07 176 794-A ist eine weißes Licht aussendende planare Lichtquelle beschrieben, bei der an einer Stirnseite einer transparenten Platte zwei blaues Licht emittierende Dioden angeordnet sind, die Licht in die transparente Platte hinein aussenden. Die transparente Platte ist auf einer der beiden einander gegenüberliegenden Hauptflächen mit einer fluoreszierenden Substanz beschichtet, die Licht emittiert, wenn sie mit dem blauen Licht der Dioden angeregt wird. Das von der fluoreszierenden Substanz emittierte Licht hat eine andere Wellenlänge als das von den Dioden emittierte blaue Licht. Bei diesem bekannten Bauelement ist es besonders schwierig, die fluoreszierende Substanz in einer Art und Weise aufzubringen, daß die Lichtquelle homogenes weißes Lichtwabstrahlt. Darüber hinaus bereitet auch die Reproduzierbarkeit, in der Massenfertigung große Probleme, weil schon geringe Schichtdickenschwankungen der fluoreszierenden Schicht, z. B. aufgrund von Unebenheiten der Oberfläche der transparenten Platte, eine Änderung des Weißtones des abgestrahlten Lichtes hervorruft.

30

35

15

20

25

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Halbleiterbauelement der eingangs genannten Art zu entwickeln, das homogenes mischfarbiges Licht abstrahlt und das eine technisch einfache Massenfertigung mit weitestgehend reproduzierbarer Bauelementcharakteristik gewährleistet.

2.73

í

The second second second

3

Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 27. Die Unteransprüche 28 bis 30 geben bevorzugte Verwendungsmöglichkeiten des erfingungsgemäßen Halbleiterbauelements an.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß der strahlungsemittierende Halbleiterkörper eine Schichtenfolge, insbesondere eine Schichtenfolge mit einer aktiven Halbleiterschicht aus GaxIn, N oder Ga.Al, .. N aufweist, die im Betrieb des Halbleiterbauelements eine elektromagnetische Strahlung eines ersten Wellenlängenbereiches aus dem ultravioletten, blauen und/oder grünen Spektralbereich aussendet. Das Lumineszenzkonversionselement wandelt einen Teil der aus dem ersten Wellenlängenbereich stammenden Strahlung in Strahlung eines zweiten Wellenlängenbereiches um, derart, daß das Halbleiterbauelement Mischstrahlung, insbesondere mischfarbiges Licht, bestehend aus Strahlung des ersten Wellenlängenbereiches und Strahlung des zweiten Wellenlängenbereiches aussendet. Das heißt beispielsweise, daß das Lumineszenzkonversionselement einen Teil der vom Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung bevorzugt nur über einen spektralen Teilbereich des ersten Wellenlängenbereichs spektral selektiv absorbiert und im längerwelligen Bereich (im zweiten Wellenlängenbereich) emittiert. Bevorzugt weist die von dem Halbleiterkörper ausgesandte Strahlung bei einer Wellenlänge $\lambda \leq 520$ nm ein relatives Intensitätsmaximum auf und liegt der von dem Lumineszenzkonversionselement spektral selektiv absorbierte Wellenlängenbereich außerhalb dieses Intensitätsmaximums.

30

10

15

20

25

Ebenso kann vorteilhafterweise mit der Erfindung auch eine Anzahl (einer oder mehrere) von aus dem ersten Wellenlängenbereich stammenden ersten spektralen Teilbereichen in mehrere zweite Wellenlängenbereiche umgewandelt werden. Dadurch ist es

4

vorteilhafterweise möglich, vielfältige Farbmischungen und Farbtemperaturen zu erzeugen.

Das erfindungsgemäße Halbleiterbauelement hat den besonderen Vorteil, daß das über Lumineszenkonversion erzeugte Wellenlängenspektrum und damit die Farbe des abgestrahlten Lichtes nicht von der Höhe der Betriebsstromstärke durch den Halbleiterkörper abhängt. Dies hat insbesondere dann große Bedeutung, wenn die Umgebungstemperatur des Halbleiterbauelementes und folglich bekanntermaßen auch die Betriebsstromstärke stark schwankt. Besonders Leuchtdioden mit einem Halbleiterkörper auf der Basis von GaN sind diesbezüglich sehr empfindlich.

10

Außerdem benötigt das erfindungsgemäße Halbleiterbauelement nur eine einzige Ansteuerspannung und damit auch nur eine einzige Ansteuerschaltungsanordnung, wodurch der Bauteileaufwand für die Ansteuerschaltung des Halbleiterbauelements sehr gering gehalten werden kann.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 20 ist als Lumineszenzkonversionselement über oder auf dem Halbleiterkörper eine teiltransparente, d. h. eine für die von dem Strahlung aussendenden Halbleiterkörper ausgesandte Strahlung teilweise transparente Lumineszenzkonversionsschicht vorgesehen. Um eine einheitliche Farbe des abstrahlten Lichtes sicher-25 zustellen, ist vorteilhafterweise die Lumineszenzkonversionsschicht derart ausgebildet, daß sie durchweg eine konstante Dicke aufweist. Dies hat den besonderen Vorteil, daß die Weglänge des von dem Halbleiterkörper abgestrahlten Lichtes durch die Lumineszenzkonversionsschicht hindurch für alle 30 Strahlungsrichtungen nahezu konstant ist. Dadurch kann erreicht werden, daß das Halbleiterbauelement in alle Richtungen Licht derselben Farbe abstrahlt. Ein weiterer besonderer Vorteil eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements gemäß dieser Weiterbildung besteht darin, daß auf einfache Weise eine hohe Re-35

e in terrapositas en la cidada. Con la fastigada en la cidada en

5

produzierbarkeit erzielt werden kann, was für eine effiziente Massenfertigung von wesentlicher Bedeutung ist. Als Lumineszenzkonversionsschicht kann beispielsweise eine mit Leuchtstoff versetzte Lack- oder Harzschicht vorgesehen sein.

5

Eine andere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes weist als Lumineszenzkonversionselement eine teiltransparente Lumineszenzkonversionsumhüllung auf, die zumindest einen Teil des Halbleiterkörpers (und evtl. Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse) umschließt und gleichzeitig als Bauteilumhüllung (Gehäuse) genutzt sein kann. Der Vorteil eines Halbleiterbauelements gemäß dieser Ausführungsform besteht im wesentlichen darin, daß zu seiner Herstellung konventionelle, für die Herstellung von herkömmlichen Leuchtdioden

(z. B. Radial-Leuchdioden) eingesetzte Produktionslinien genutzt werden können. Für die Bauteilumhüllung ist anstelle des bei herkömmlichen Leuchtdioden dafür verwendeten transparenten Kunststoffes das Material der Lumineszenzkonversionsumhüllung verwendet.

20

25

30

Bei weiteren vorteilhaften Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements und der beiden oben genannten bevorzugten Ausführungsformen besteht die Lumineszenzkonversionsschicht bzw. die Lumineszenzkonversionsumhüllung aus einem transparenten Material, z. B. Kunststoff, bevorzugt Epoxidharz, das mit mindestens einem Leuchtstoff versehen ist (Beispiele für bevorzugte Kunststoffe und Leuchtstoffe finden sich weiter unten). Auf diese Weise lassen sich Lumineszenzkonversionselemente besonders kostengünstig herstellen. Die dazu notwendigen Verfahrensschritte sind nämlich ohne großen Aufwand in herkömmliche Produktionslinien für Leuchtdioden integrierbar.

A WASHING TO WELL BY THE STATE OF THE

en en Maria de Santo de Carlos Carlos de C Carlos de Car

til en stragger i de de trade e

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung bzw. der o. g. Ausführungsformen ist vorgesehen, daß der oder

6

die zweiten Wellenlängenbereiche im Wesentlichen größere Wellenlängen aufweisen als der erste Wellenlängenbereich.

Insbesondere ist vorgesehen, daß ein zweiter spektraler Teilbereich des ersten Wellenlängenbereiches und ein zweiter Wellenlängenbereich zueinander komplementär sind. Auf diese Weise kann aus einer einzigen farbigen Lichtquelle, insbesondere einer Leuchtdiode mit einem einzigen blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörper, mischfarbiges, insbesondere weißes Licht erzeugt werden. Um z. B. mit einem blaues Licht aussendenden Halbleiterkörper weißes Licht zu erzeugen, wird ein Teil der von dem Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung aus dem blauen Spektralbereich in den zu Blau komplementärfarbigen gelben Spektralbereich konvertiert. Die Farbtemperatur oder Farbort des weißen Lichtes kann dabei durch geeignete Wahl des Lumineszenzkonversionselementes, insbesondere durch eine geeignete Wahl des Leuchtstoffes, dessen Partikelgröße und dessen Konzentration, variiert werden. Darüberhinaus bieten diese Anordnungen vorteilhafterweise auch die Möglichkeit, Leuchtstoffmischungen einzusetzen, wodurch sich vorteilhafterweise der gewünschte Farbton sehr genau einstellen läßt. Ebenso können Lumineszenzkonversionselemente inhomogen ausgestaltet sein, z. B. mittels einer inhomogenen Leuchtstoffverteilung. Unterschiedliche Weglängen des Lichtes durch das Lumineszenzkonversionselement können dadurch vorteilhafterweise kompensiert werden.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements weist das Lumineszenzkonversionselement oder ein anderer Bestandteil einer Bauteilumhüllung zur Farbanpassung einen oder mehrere Farbstoffe auf, die keine Wellenlängenkonversion bewirken. Hierzu können die für die Herstellung von herkömmlichen Leuchdioden verwendeten Farbstoffe wie z. B. Azo-, Anthrachinon- oder Perinon-Farbstoffe eingesetzt werden.

the second second

e e ligações como esta de la c La como esta de la como esta d

10

20

25

3.0

en ja kitti kan kenkela 1996-1996. Patri kan dilatan pendalah sebagai kendalah sebagai kendalah sebagai kendalah sebagai kendalah sebagai kendal Reservation dilatan beragai kendalah sebagai kendalah sebagai kendalah sebagai kendalah sebagai kendalah sebag

* * *

7

Zum Schutz des Lumineszenzkonversionselements vor einer zu hohen Strahlenbelastung ist bei einer vorteilhaften Weiterbildung bzw. bei den o. g. bevorzugten Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements zumindest ein Teil der Oberfläche des Halbleiterkörpers von einer ersten, z. B. aus einem Kunststoff bestehenden transparenten Hülle umgeben, auf der die Lumineszenzkonversionsschicht aufgebracht ist. Dadurch wird die Strahlungsdichte im Lumineszenzkonversionselement und somit dessen Strahlungsbelastung verringert, was sich je nach verwendeten Materialien positiv auf die Lebensdauer des Lumineszenzkonversionselementes auswirkt.

10

15

20

25

30

35

Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sowie der oben genannten Ausführungsformen ist ein strahlungsemittierender Halbleiterkörper verwendet, bei dem das ausgesandte Strahlungsspektrum bei einer Wellenlänge zwischen 420nm und 460 nm, insbesondere bei 430 nm (z. B. Halbleiterkörper auf der Basis von Ga_xAl_{1-x}N) oder 450 nm (z. B. Halbleiterkörper auf der Basis von Ga_xIn_{1-x}N) ein Intensitätsmaximum aufweist. Mit einem derartigen erfindungsgemäßen Halbleiterbauelement lassen sich vorteilhafterweise nahezu sämtliche Farben und Mischfarben der C.I.E.-Farbtafel erzeugen. Der strahlungsemittierende Halbleiterkörper kann hierbei, wie oben angegeben, im Wesentlichen aus elektrolumineszierendem Halbleitermaterial aber auch aus einem anderen elektrolumineszierenden Material, wie beispielsweise Polymermaterial bestehen.

Bei einer weiteren besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung und deren Ausführungsformen ist die Lumineszenzkonversionsumhüllung bzw. die Lumineszenzkonversionsschicht aus einem Lack oder aus einem Kunststoff hergestellt, beispielsweise aus einem für die Umhüllung optoelektronischer Bauelemente eingesetzten Silikon-, Thermoplast- oder Duroplastmaterial (Epoxidu. Acrylatharze). Desweiteren können z. B. aus Thermoplastmaterialien gefertigte Abdeckelemente als Lumineszenzkonversionsum-

25

30

8

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

hüllung eingesetzt sein. Sämtliche oben genannten Materialien lassen sich auf einfache Weise mit einem oder mehreren Leuchtstoffen versetzen.

Besonders einfach läßt sich ein erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement dann realisieren, wenn der Halbleiterkörper in einer Ausnehmung eines gegebenenfalls vorgefertigten Gehäuses angeordnet ist und die Ausnehmung mit einem die Lumineszenzkonversionsschicht aufweisenden Abdeckelement versehen ist. Ein derartiges Halbleiterbauelement läßt sich in großer Stückzahl in 10 herkömmlichen Produktionslinien herstellen. Hierzu muß lediglich nach der Montage des Halbleiterkörpers in das Gehäuse das Abdeckelement, beispielsweise eine Lack- oder Gießharzschicht oder eine vorgefertigtes Abdeckplatte aus Thermoplastmaterial, auf das Gehäuse aufgebracht werden. Optional kann die Ausneh-15 mung des Gehäuses mit einem transparenten Material, beispielsweise einem transparenten Kunststoff, gefüllt sein, das insbesondere die Wellenlänge des von dem Halbleiterkörper ausgesandten Lichtes nicht verändert oder aber, falls gewünscht, bereits lumineszenzkonvertierend ausgebildet sein kann. 20

Bei einer aufgrund besonders einfacher Realisierbarkeit besonders bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements ist der Halbleiterkörper in einer Ausnehmung eines gegebenenfalls vorgefertigten eventuell bereits mit einem Leadframe versehenen Gehäuse angeordnet und ist die Ausnehmung mit einem zumindest teiltransparenten Gießharz gefüllt, dem der Leuchtstoff bereits vor dem Ausgießen der Ausnehmung zugefügt ist. Das Lumineszenzkonversionselement ist hier somit von dem mit Leuchtstoff versehenen Verguß des Halbleiterkörpers versehen.

Ein besonders bevorzugtes Material zur Herstellung des Lumineszenzkonversionselements ist Epoxidharz, dem ein oder mehrere

9

Leuchtstoffe zugesetzt sind. Anstelle von Bpoxidharz kann aber auch Polymethylmetacrylat (PMMA) verwendet sein.

PMMA läßt sich auf einfache Weise mit organischen Farbstoffmolekülen versetzen. Zur Herstellung von grün-, gelb- und rotleuchtenden erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen können z. B. Farbstoffmoleküle auf Perylen-Basis verwendet sein. Im UV, im Sichtbaren oder im Infraroten leuchtende Halbleiterbauelemente können auch durch Beimischung von 4f-metallorganischen
 Verbindungen hergestellt werden. Insbesondere können rotleuchtende erfindungsgemäße Halbleiterbauelemente z. B. durch Beimischung von auf Eu³+ basierenden metallorganischen Chelaten (λ ≈ 620 nm) realisiert werden. Infrarot strahlende erfindungsgemäße Halbleiterbauelemente, insbesondere mit blaues Licht aussendenden Halbleiterkörpern, können mittels Beimischung von 4f-Chelaten oder von Ti³+-dotiertem Saphir hergestellt werden.

Ein weißes Licht abstrahlendes erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement läßt sich vorteilhafterweise dadurch herstellen, daß
der Leuchtstoff so gewählt wird, daß eine von dem Halbleiterkörper ausgesandte blaue Strahlung in komplementäre Wellenlängenbereiche, insbesondere Blau und Gelb, oder zu additiven
Farbtripeln, z. B. Blau, Grün und Rot umgewandelt wird. Hierbei
wird das gelbe bzw. das grüne und rote Licht über die Leuchtstoffe erzeugt. Der Farbton (Farbort in der CIE-Farbtafel) des
dadurch erzeugten weißen Lichts kann dabei durch geeignete Wahl
des/der Farbstoffes/e hinsichtlich Mischung und Konzentration
variiert werden.

20

25

Geeignete organische Leuchtstoffe für ein weißes Licht abstrahlendes erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement sind PerylenLeuchtstoffe wie z. B. BASF Lumogen F 083 für grüne Lumineszenz, BASF Lumogen F 240 für gelbe Lumineszenz und BASF Lumogen
F 300 für rote Lumineszenz. Diese Farbstoffe lassen sich auf
einfache Weise z. B. transparentem Epoxidharz zusetzen.

Eine bevorzugte Methode, mit einem blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörper ein grün leuchtendes Halbleiterbauelement herzustellen, besteht darin, für das Lumineszenzkonversionselement ${\rm UO_2}^{**}$ -substituiertes Borsilikatglas zu verwenden.

Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements bzw. der oben angegebenen vorteilhaften Ausführungsformen sind dem Lumineszenzkonversionselement oder einer anderen strahlungsdurchlässigen Komponente der Bauteilumhüllung zusätzlich lichtstreuende Partikel, sogenannte Diffusoren zugesetzt. Hierdurch läßt sich vorteilhafterweise der Farbeindruck und die Abstrahlcharakteristik des Halbleiterbauelements optimieren.

15

20

25

30

35

10

Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements besteht das Lumineszenzkonversionselement zumindest teilweise aus einem transparenten Epoxidharz, das mit einem anorganischen Leuchtstoff versehen ist. Vorteilhafterweise lassen sich nämlich anorganische Leuchtstoffe auf einfache Weise in Epoxidharz einbinden Ein besonders bevorzugter anorganischer Leuchtstoff zur Herstellung von Weiß leuchtenden erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen ist der Phosphor YAG:Ce (Y3Al5O12:Ce3+). Dieser läßt sich auf besonders einfache Weise in herkömmlich in der LED-Technik verwendeten transparenten Epoxidharzen mischen. Weiterhin als Leuchtstoffe denkbar sind weitere mit Seltenen Erden dotierte Granate wie z. B. $Y_3Ga_5O_{12}:Ce^{3+}$, $Y(Al,Ga)_5O_{12}:Ce^{3+}$ und Y(Al,Ga)₅O₁₂:Tb³⁺ sowie mit Seltenen Erden dotierte Erdalkali-Sulfide wie z. B. SrS:Ce³⁺,Na, SrS:Ce³⁺,Cl, SrS:CeCl₃, CaS:Ce³⁺ und SrSe:Ce3+.

Zur Erzeugung von verschiedenartig mischfarbigem Licht eignen sich darüberhinaus besonders die mit Seltenen Erden dotierten Thiogallate wie z. B. $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$ und $SrGa_2S_4:Ce^{3+}$. Ebenso ist

and the second second second

hierzu die Verwendung von mit Seltenen Erden dotierten Aluminaten wie z. B. $YAlO_3:Ce^{3+}$, $YGaO_3:Ce^{3+}$, $Y(Al,Ga)O_3:Ce^{3+}$ und mit Seltenen Erden dotierten Orthosilikaten $M_2SiO_5:Ce^{3+}$ (M: Sc, Y, Sc) wie z. B. $Y_2SiO_5:Ce^{3+}$ denkbar. Bei allen Yttriumverbindungen kann das Yttrium im Prinzip auch durch Scandium oder Lanthan ersetzt werden.

Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements bestehen zumindest alle lichtdurchstrahlten Komponenten der Umhüllung, d. h. auch die Lumineszenzkonversionsumhüllung bzw. -schicht aus rein anorganischen Materialien. Das Lumineszenzkonversionselement besteht somit aus einem anorganischen Leuchtstoff, der in einem temperaturstabilen, transparenten oder teiltransparenten anorganischen Material eingebettet ist. Insbesondere besteht das Lumineszenzkonversionselement aus einem anorganischen Phosphor, der in ein vorteilhafterweise niedrig schmelzendes anorganisches Glas (z. B. Silikatglas) eingebettet ist. Eine bevorzugte Herstellungsweise für eine derartige Lumineszenzkonversionsschicht ist die Sol-Gel-Technik, mit der die gesamte Lumineszenzkonversionsschicht, d. h. sowohl der anorganische Leuchtstoff als auch das Einbettmaterial in einem Arbeitsgang hergestellt werden kann.

10

15

20

25

Um die Durchmischung der von dem Halbleiterkörper ausgesandten Strahlung des ersten Wellenlängenbereiches mit der lumineszenz-konvertierten Strahlung des zweiten Wellenlängebereiches und damit die Farbhomogenität des abstrahlten Lichtes zu verbessern, ist bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements der Lumineszenzumhüllung bzw. der Lumineszenzkonversionsschicht und/oder einer anderen Komponente der Bauteilumhüllung zusätzlich ein im Blauen lumineszierender Farbstoff zugefügt, der eine sogenannte Richtcharakteristik der von dem Halbleiterkörper abgestrahlten Strahlung abschwächt. Unter Richtcharakteristik ist zu verstehen, daß die von dem

o 100 dasember 1992 eta 1990. O katoliko 1912 eta 1902 eta 1907. O la dasember 1992 eta 1903 eta 1903.

a in garage de la companya di la com

WO 97/50132

12

State of the Contract of the C

4.

Andrew State of the Control of the C

e de la Salada de Perada de la Carlo de Perada de la Carlo de la La Carlo de la

· · · · · · ·

Halbleiterkörper ausgesandte Strahlung eine bevorzugte Abstrahlrichtung aufweist.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements ist zum oben genannten Zweck der Durchmischung der ausgesandten Strahlung der anorganische Leuchtstoff in Pulverform verwendet, wobei sich die Leuchtstoffpartikel in dem sie umhüllenden Stoff (Matrix) nicht lösen. Außerdem
weisen der anorganische Leuchtstoff und der ihn umhüllende
 Stoff voneinander verschiedene Brechungsindizes auf. Dies führt
vorteilhafterweise dazu, daß abhängig von der Korngröße des
Leuchtstoffes, ein Anteil des nicht vom Leuchtstoff absorbierten Lichtes gestreut wird. Dadurch ist die Richtcharakteristik
der von dem Halbleiterkörper abgestrahlten Strahlung effizient
 geschwächt, so daß die nicht absorbierte Strahlung und die lumineszenzkonvertierte Strahlung homogen gemischt werden, was zu
einem räumlich homogenen Parbeindruck führt.

Ein weißes Licht abstrahlendes erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement läßt sich besonders bevorzugt dadurch realisieren, daß einem zur Herstellung der Lumineszenzkonversionsumhüllung oder -schicht verwendeten Epoxidharz der anorganische Leuchtstoff YAG:Ce $(Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+})$ beigemischt ist. Ein Teil einer von dem Halbleiterkörper ausgesandten blauen Strahlung wird von dem anorganischen Leuchtstoff $Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$ in den gelben Spektralbereich und somit in einen zur Farbe Blau komplementärfarbigen Wellenlängenbereich verschoben. Der Farbton (Farbort in der CIE-Farbtafel) des weißen Lichts kann dabei durch geeignete Wahl der Farbstoffmischung und -konzentration variiert werden.

30

35

20

Der anorganische Leuchtstoff YAG:Ce hat unter anderem den besonderen Vorteil, daß es sich hierbei um nicht lösliche Farbpigmente (Partikelgröße im Bereich von 10 μ m) mit einem Brechungsindex von ca. 1,84 handelt. Dadurch tritt neben der Wellenlängenkonversion noch ein Streueffekt auf, der zu einer gu-

13

والأراب المراسي

ten Vermischung von blauer Diodenstrahlung und gelber Konverterstrahlung führt.

Bei einer weiteren bevorzugten Weiterbildung eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements bzw. der oben angegebenen vorteilhaften Ausführungsformen sind dem Lumineszenzkonversionselement oder einer anderen strahlungsdurchlässigen Komponente
der Bauteilumhüllung zusätzlich lichtstreuende Partikel, sogenannte Diffusoren zugesetzt. Hierdurch läßt sich vorteilhafterweise der Farbeindruck und die Abstrahlcharakteristik des Halbleiterbauelements weiter optimieren.

Von besonderem Vorteil ist, daß die Leuchteffizienz von weißleuchtenden erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen bzw. deren
o. g. Ausführungsformen mit einem im wesentlichen auf der Basis
von GaN hergestellten blau leuchtenden Halbleiterkörper vergleichbar ist mit der Leuchteffizienz einer Glühbirne. Der
Grund dafür besteht darin, daß zum einen die externe Quantenausbeute derartiger Halbleiterkörper bei einigen Prozent liegt
und andererseits die Lumineszenzausbeute von organischen Farbstoff-Molekülen oft bei über 90% angesiedelt ist. Darüberhinaus
zeichnet sich das erfindungsgemäße Halbleiterbauelement im Vergleich zur Glühbirne durch eine extrem lange Lebensdauer, größere Robustheit und eine kleinere Betriebsspannung aus.

25

30

Vorteilhaft ist weiterhin, daß die für das menschliche Auge wahrnehmbare Helligkeit des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements gegenüber einem ohne Lumineszenzkonversionselement ausgestatteten, aber sonst identischen Halbleiterbauelement deutlich erhöht werden kann, da die Augenempfindlichkeit zu höherer Wellenlänge hin zunimmt.

Control of the second

Continue to the continue of

Darüberhinaus kann mit dem erfindungsgemäßen Prinzip vortteilhafterweise auch eine von dem Halbleiterkörper neben der sichtbaren Strahlung ausgesandte ultraviolette Strahlung in sichtba-

The second of th and the part of the second

res Licht umgewandelt werden. Dadurch wird die Helligkeit des vom Halbleiterkörper ausgesandten Lichts deutlich erhöht.

Das hier vorgestellte Konzept der Lumineszenzkonversion mit blauem Licht eines Halbleiterkörpers läßt sich vorteilhafterweise auch auf mehrstufige Lumineszenzkonversionselemente erweitern, nach dem Schema ultraviolett \rightarrow blau \rightarrow grün \rightarrow gelb \rightarrow rot. Hierbei werden eine Mehrzahl von spektral selektiv emittierenden Lumineszenzkonversionselementen relativ zum Halbleiterkörper hintereinander angeordnet. 10

Ebenso können vorteilhafterweise mehrere unterschiedlich spektral selektiv emittierende Farbstoffmoleküle gemeinsam in einen transparenten Kunststoff eines Lumineszenzkonversionselements eingebettet sein. Hierdurch ist ein sehr breites Farbenspektrum erzeugbar.

Ein besonderer Vorteil von erfindungsgemäßen weißes Licht abstrahlenden Halbleiterbauelementen, bei denen als Lumineszenz-20 konversionsfarbstoff insbesondere YAG:Ce verwendet ist, besteht darin, daß dieser Leuchtstoff bei Anregung mit blauem Licht eine spektrale Verschiebung von ca. 100 nm zwischen Absorption und Emission bewirkt. Dies führt zu einer wesentlichen Reduktion der Reabsorption des vom Leuchtstoff emittierten Lichtes und damit zu einer höheren Lichtausbeute. Außerdem besitzt YAG:Ce vorteilhafterweise eine hohe thermische und photochemische (z. B. UV-) Stabilität (wesentlich höher als organische Leuchtstoffe), so daß auch Weiß leuchtende Dioden für Außenanwendung und/oder hohe Temperaturbereiche herstellbar sind.

30

35

25

15

YAG: Ce hat sich bislang hinsichtlich Reabsorption, Lichtausbeute, thermischer und photochemischer Stabilität und Verarbeitbarkeit als am besten geeigneter Leuchtstoff herausgestellt. Denkbar ist jedoch auch die Verwendung von anderen Ce-dotierten Phosphoren, insbesondere Ce-dotierten Granaten.

15

Besonders vorteilhaft lassen sich erfindungsgemäße Halbleiterbauelemente insbesondere aufgrund ihrer geringen Leistungsaufnahme in vollfarbtauglichen LED-Displays, zur Beleuchtung von Kfz-Innenräumen oder von Flugzeugkabinen sowie zur Beleuchtung von Anzeigevorrichtungen wie Kfz-Armaturen oder Flüssigkristallanzeigen verwenden.

- Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von 9 Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren 1 bis 14. Es zeigen:
- Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines ersten Ausfüh-15 rungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements; Figur 2 eine schematische Schnittansicht eines zweiten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes; Figur 3 eine schematische Schnittansicht durch ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäße Halbleiterbauelementes; 20 Figur 4 eine schematische Schnittansicht eines vierten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements; Figur 5 eine schematische Schnittansicht eines fünften Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes; Figur 6 eine schematische Schnittansicht eines sechsten Ausfüh-25 rungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes; Figur 7 eine schematische Darstellung eines Emissionsspektrums eines blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörpers mit einer Schichtenfolge auf der Basis von GaN;
- Figur 8 eine schematische Darstellung der Emissionsspektren zweier erfindungsgemäßer Halbleiterbauelemente, die weißes Licht abstrahlen;
 Figur 9 eine schematische Schnittdarstellung durch einen Halbleiterkörper, der blaues Licht aussendet;

The same of the sa

Figur 10 eine schematische Schnittansicht eines siebten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes; Figur 11 eine schematische Darstellung eines Emissionsspektrums eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes, das mischfarbiges rotes Licht abstrahlt;

Figur 12 eine schematische Darstellung der Emissionsspektren von weiteren erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen, die weißes Licht abstrahlen;

Figur 13 eine schematische Schnittansicht eines achten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßene Halbleiterbauelementes und

Figur 14 eine schematische Schnittansicht eines neunten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementes.

15

20

25

10

In den verschiedenen Figuren sind gleiche bzw. gleichwirkende Teile immer mit denselben Bezugszeichen bezeichnet.

.

Bei dem in Figur 1 dargestellten Licht aussendenden Halbleiterbauelement weist ein Halbleiterkörper 1 einen Rückseitenkontakt 11, einen Vorderseitenkontakt 12 und eine sich aus einer Anzahl von unterschiedlichen Schichten zusammensetzende Schichtenfolge 7 auf, die im Betrieb des Halbleiterbauelements mindestens eine eine Strahlung (z. B. ultraviolett, blau oder grün) aussendende aktive Zone besitzt.

Ein Beispiel für eine geeignete Schichtenfolge 7 für dieses und für sämtliche im folgenden beschriebenen Ausführungsbeispiele ist in Figur 9 gezeigt. Hierbei ist auf einem Substrat 18, das z. B. aus SiC besteht, eine Schichtenfolge aus einer AlN- oder GaN-Schicht 19, einer n-leitenden GaN-Schicht 20, einer n-leitenden Ga_xAl_{1-x}N- oder Ga_xIn_{1-x}N-Schicht 21, einer weiteren n-leitenden GaN- oder einer Ga_xIn_{1-x}N-Schicht 22, einer p-leitenden Ga_xAl_{1-x}N- oder Ga_xIn_{1-x}N-Schicht 23 und einer p-leitenden GaN-Schicht 24 aufgebracht. Auf einer Hauptfläche 25

17

der p-leitenden GaN-Schicht 24 und einer Hauptfläche 26 des Substrats 18 ist jeweils eine Kontaktmetallisierung 27, 28 aufgebracht, die aus einem herkömmlich in der Opto-

 Halbleitertechnik für elektrische Kontakte verwendeten Werkstoff besteht.

10

15

20

25

30

35

Es kann jedoch auch jeder andere dem Fachmann für das erfindungsgemäße Halbleiterbauelement als geeignet erscheinende Halbleiterkörper verwendet werden. Dies gilt ebenso für sämtliche nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispiele.

Im Ausführungsbeispiel von Figur 1 ist der Halbleiterkörper 1 mittels eines elektrisch leitenden Verbindungsmittels, z.B. ein metallisches Lot oder ein Klebstoff, mit seinem Rückseitenkontakt 11 auf einem ersten elektrischen Anschluß 2 befestigt. Der Vorderseitenkontakt 12 ist mittels eines Bonddrahtes 14 mit einem zweiten elektrischen Anschluß 3 verbunden.

The second was a second

1 3 1 1 1 1 1 1 1

Carlotte Commence of the St.

Die freien Oberflächen des Halbleiterkörpers 1 und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2 und 3 sind unmittelbar von einer Lumineszenzkonversionsumhüllung 5 umschlossen. Diese besteht bevorzugt aus einem für transparente Leuchtdiodenumhüllungen verwendbaren transparenten Kunststoff (bevorzugt Epoxidharz oder auch Polymethylmetaacrylat), der mit Leuchtstoff 6, bevorzugt anorganischer Leuchtstoff, für Weiß leuchtende Bauelemente bevorzugt $Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$ (YAG:Ce), versetzt ist.

Das in Figur 2 dargestellte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements unterscheidet sich von dem der Figur 1 dadurch, daß der Halbleiterkörper 1 und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2 und 3 anstatt von einer Lumineszenzkonversionsumhüllung von einer transparenten Umhüllung 15 umschlossen sind. Diese transparente Umhüllung 15 bewirkt keine Wellenlängenänderung der von dem Halbleiterkörper 1 ausgesandten Strahlung und besteht beispielsweise aus einem in der

18

a a caste audita de como de como de como. O a como se trada de caste de como de

Commence of the second

والأمال والمراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

· was ·

A STANK CONTRACTOR OF THE SECOND

Leuchtdiodentechnik herkömmlich verwendeten Epoxid-, Silikonoder Acrylatharz oder aus einem anderen geeigneten strahlungsdurchlässigen Material wie z. B. anorganisches Glas.

Auf diese transparente Umhüllung 15 ist eine Lumineszenzkonversionsschicht 4 aufgebracht, die, wie in der Figur 2 dargestellt, die gesamte Oberfläche der Umhüllung 15 bedeckt. Ebenso denkbar ist, daß die Lumineszenzkonversionsschicht 4 nur einen Teilbereich dieser Oberfläche bedeckt. Die Lumineszenzkonversionsschicht 4 besteht beispielsweise wiederum aus einem transparenten Kunststoff (z. B. Epoxidharz, Lack oder Polymethylmetaacrylat), der mit einem Leuchtstoff 6 versetzt ist. Auch hier eignet sich als Leuchtstoff für ein weiß leuchtendes Halbleiterbauelement bevorzugt YAG:Ce.

15

20

25

30

Dieses Ausführungsbeispiel hat den besonderen Vorteil, daß für die gesamte von dem Halbleiterkörper ausgesandte Strahlung die Weglänge durch das Lumineszenzkonverionselement näherungsweise gleich groß ist. Dies spielt insbesondere dann eine bedeutende Rolle, wenn, wie oftmals der Fall, der genaue Farbton des von dem Halbleiterbauelement abgestrahlten Lichtes von dieser Weglänge abhängt.

Zur besseren Auskopplung des Lichtes aus der Lumineszenzkonversionsschicht 4 von Figur 2 kann auf einer Seitenfläche des Bauelements eine linsenförmige Abdeckung 29 (gestrichelt eingezeichnet) vorgesehen sein, die eine Totalreflexion der Strahlung innerhalb der Lumineszenzkonversionsschicht 4 reduziert. Diese linsenförmige Abdeckung 29 kann aus transparentem Kunststoff oder Glas bestehen und auf die Lumineszenzkonversionsschicht 4 beispielsweise aufgeklebt oder direkt als Bestandteil der Lumineszenzkonversionsschicht 4 ausgebildet sein.

Bei dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel sind der 35 erste und zweite elektrische Anschluß 2/3 in ein lichtundurch-

* ACTAIL

The second of the problem of the second of t

The source of the second

2000

19

lässiges evtl. vorgefertigtes Grundgehäuse 8 mit einer Ausnehmung 9 eingebettet. Unter "vorgefertigt" ist zu verstehen, daß das Grundgehäuse 8 bereits an den Anschlüssen 2,3 beispielsweise mittels Spritzguß fertig ausgebildet ist, bevor der Halbleiterkörper auf den Anschluß 2 montiert wird. Das Grundgehäuse 8 besteht beispielsweise aus einem lichtundurchlässigen Kunststoff und die Ausnehmung 9 ist hinsichtlich ihrer Form als Reflektor 17 für die vom Halbleiterkörper im Betrieb ausgesandte Strahlung (ggf. durch geeignete Beschichtung der Innenwände der Ausnehmung 9) ausgebildet. Solche Grundgehäuse 8 werden insbesondere bei auf Leiterplatten oberflächenmontierbaren Leuchtdioden verwendet. Sie werden vor der Montage der Halbleiterkörper auf ein die elektrischen Anschlüsse 2,3 aufweisendes Leiterband (Leadframe) z. B. mittels Spritzgießen aufgebracht.

15

20

25

10

Die Ausnehmung 9 ist von einer Lumineszenzkonversionsschicht 4, beispielsweise eine separat hergestellte und auf dem Grundgehäuse 8 befestigte Abdeckplatte 17 aus Kunststoff abgedeckt. Als geeignete Materialien für die Lumineszenzkonversionsschicht 4 kommen wiederum die weiter oben im allgemeinen Teil der Beschreibung genannten Kunststoffe oder anorganisches Glas in Verbindung mit den dort genannten Leuchtstoffen in Frage. Die Ausnehmung 9 kann sowohl mit einem transparenten Kunststoff, mit einem anorganischen Glas oder mit Gas gefüllt als auch mit einem Vakuum versehen sein.

Wie bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2 kann auch hier zur besseren Auskopplung des Lichtes aus der Lumineszenzkonversionsschicht 4 auf dieser eine linsenförmige Abdeckung 29

(gestrichelt eingezeichnet) vorgesehen sein, die eine Totalreflexion der Strahlung innerhalb der Lumineszenzkonversionsschicht 4 reduziert. Diese Abdeckung 29 kann aus transparentem Kunststoff bestehen und auf die Lumineszenzkonversionsschicht 4

beispielsweise aufgeklebt oder zusammen mit der Lumineszenzkonversionsschicht 4 einstückig ausgebildet sein.

20

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Ausnehmung 9, wie in Figur 10 gezeigt, mit einem mit Leuchtstoff versehenen Epoxidharz, d. h. mit einer Lumineszenzumhüllung 5 gefüllt, die das Lumineszenzkonversionselement bildet. Eine Abdeckplatte 17 und/oder eine linsenförmige Abdeckung 29 kann dann auch weggelassen sein. Weiterhin ist optional, wie in Figur 13 dargestellt, der erste elektrische Anschluß 2 z. B. durch Prägen im Bereich des Halbleiterkörpers 1 als Reflektorwanne 34 ausgebildet, die mit einer Lumineszenzkonversionsumhüllung 5 gefüllt ist.

In Figur 4 ist als weiteres Ausführungsbeispiel eine sogenannte Radialdiode dargestellt. Hierbei ist der Halbleiterkörper 1 in einem als Reflektor ausgebildeten Teil 16 des ersten elektrischen Anschlußes 2 beispielsweise mittels Löten oder Kleben befestigt. Derartige Gehäusebauformen sind in der Leuchtdiodentechnik bekannt und bedürfen von daher keiner näheren Erläuterung.

and the second of the second

20

25

10

15

Bei dem Ausführungsbeispiel von Figur 4 ist der Halbleiterkörper 1 von einer transparenten Umhüllung 15 umgeben, die, wie beim zweitgenannten Ausführungsbeispiel (Figur 2), keine Wellenlängenänderung der von dem Halbleiterkörper 1 ausgesandten Strahlung bewirkt und beispielsweise aus einem herkömmlich in der Leuchtdiodentechnik verwendeten transparenten Epoxidharz oder aus organischem Glas bestehen kann.

Auf dieser transparenten Umhüllung 15 ist eine Lumineszenzkonversionsschicht 4 aufgebracht. Als Material hierfür kommen beispielsweise wiederum die im Zusammenhang mit den vorgenannten
Ausführungsbeispielen angeführten Kunststoffe oder anorganisches Glas in Verbindung mit den dort genannten Farbstoffen in
Frage.

and the state of t

*

21

Der gesamte Aufbau, bestehend aus Halbleiterkörper 1, Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2,3, transparente Umhüllung 15 und Lumineszenzkonversionsschicht 4, ist unmittelbar von einer weiteren transparenten Umhüllung 10 umschlossen, die keine Wellenlängenänderung der durch die Lumineszenzkonversionsschicht 4 hindurchgetretenen Strahlung bewirkt. Sie besteht beispielsweise wiederum aus einem herkömmlich in der Leuchtdiodentechnik verwendeten transparenten Epoxidharz oder aus anorganischem Glas.

10

15

20

25

30

35

Das in Figur 5 gezeigte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem von Figur 4 im wesentlichen dadurch, daß die freien Oberflächen des Halbleiterkörpers 1. unmittelbar von einer Lumineszenzkonversionsumhüllung 5 bedeckt sind, die wiederum von einer weiteren transparenten Umhüllung 10 umgeben ist. In Figur 5 ist weiterhin beispielhaft ein Halbleiterkörper 1 dargestellt, bei dem anstelle des Unterseitenkontaktes ein weiterer Kontakt auf der Halbleiterschichtenfolge 7 angebracht ist, der mittels eines zweiten Bonddrahtes 14 mit dem zugehörigen elektrischen Anschluß 2 oder 3 verbunden ist. Selbstverständlich sind derartige Halbleiterkörper 1 auch bei allen anderen hierin beschriebenen Ausführungsbeispielen einsetzbar. Umgekehrt ist natürlich auch bei dem Ausführungsbeispiel von Figur 5 ein Halbleiterkörper 1 gemäß den vorgenannten Ausführungsbeispielen verwendbar.

Der Vollständikeit halber sei an dieser Stelle angemerkt, daß selbstverständlich auch bei der Bauform nach Figur 5 analog zu dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 eine einstückige Lumineszenzkonversionsumhüllung 5, die dann an die Stelle der Kombination aus Lumineszenzkonversionsumhüllung 5 und weiterer transparenter Umhüllung 10 tritt, verwendet sein kann.

Bei dem Ausführungsbeispiel von Figur 6 ist eine Lumineszenzkonversionsschicht 4 (mögliche Materialien wie oben angegeben)

i katalog i miji ake i sakiti katalog Miji sakata kapi ake ake sakiti katalog Miji sakata kapi

. •

10

35

direkt auf den Halbleiterkörper 1 aufgebracht. Dieser und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse 2,3 sind von einer weiteren transparenten Umhüllung 10 umschlossen, die keine Wellenlängenänderung der durch die Lumineszenzkonversionsschicht 4 hindurchgetretenen Strahlung bewirkt und beispielsweise aus einem in der Leuchtdiodentechnik verwendbaren transparenten Epoxidharz oder aus Glas gefertigt ist.

Solche, mit einer Lumineszenzkonversionsschicht 4 versehenen Halbleiterkörper 1 ohne Umhüllung können natürlich vorteilhafterweise in sämtlichen aus der Leuchtdiodentechnik bekannten Gehäusebauformen (z. B. SMD-Gehäuse, Radial-Gehäuse (man vergleiche Figur 5)) verwendet sein.

15 Bei dem in Figur 14 dargestellten Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements ist auf dem Halbleiterkörper 1 ein transparentes Wannenteil 35 angeordnet, das über dem Halbleiterkörper 1 eine Wanne 36 aufweist. Das Wannenteil 35 besteht beispielsweise aus transparentem Epoxidharz oder aus anorganischem Glas und ist z. B. mittels Umspritzen der elek-20 trischen Anschlüsse 2,3 einschließlich Halbleiterkörper 1 gefertigt. In dieser Wanne 36 ist eine Lumineszenzkonversionsschicht 4 angeordnet, die z. B. wiederum aus Epoxidharz oder anorganischem Glas gefertigt ist, in das Partikel 37, bestehend aus einem der o. g. anorganischen Leuchtstoffe, eingebunden 25 sind. Bei dieser Bauform wird vorteilhafterweise auf sehr einfache Weise sichergestellt, daß sich der Leuchtstoff während der Herstellung des Halbleiterbauelements an nicht vorgesehenen Stellen, z. B. neben dem Halbleiterkörper, ansammelt. Das Wan-30 nenteil 35 kann selbstverständlicherweise auch separat hergestellt und anderweitig, z. B. an einem Gehäuseteil, über dem Halbleiterkörper 1 befestigt sein.

Bei sämtlichen der oben beschriebenen Ausführungsbeispiele kann zur Optimierung des Farbeindrucks des abstrahlten Lichts sowie

23

zur Anpassung der Abstrahlcharakteristik das Lumineszenzkonversionselement (Lumineszenzkonversionsumhüllung 5 oder Lumineszenzkonversionsschicht 4), ggf. die transparente Umhüllung 15, und/oder ggf. die weitere transparente Umhüllung 10 lichtstreuende Partikel, vorteilhafterweise sogenannte Diffusoren aufweisen. Beispiele für derartige Diffusoren sind mineralische Füllstoffe, insbesondere CaF₂, TiO₂, SiO₂, CaCO₃ oder BaSO₄ oder auch organische Pigmente. Diese Materialien können auf einfache Weise den o. g. Kunststoffen zugesetzt werden:

10

In den Figuren 7, 8 und 12 sind Emissionsspektren eines blaues Licht abstrahlenden Halbleiterkörpers (Fig. 7) (Lumineszenzmaximum bei $\lambda \sim 430$ nm) bzw. von mittels eines solchen Halbleiterkörpers hergestellten Weiß leuchtenden erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen (Fig. 8 und 12) gezeigt. An der Abszisse ist jeweils die Wellenänge λ in nm und auf der Ordinate ist jeweils eine relative Elektrolumineszenz(EL)-Intensität aufgetragen.

Von der vom Halbeiterkörper ausgesandten Strahlung nach Figur 7 20 wird nur ein Teil in einen längerwelligen Wellenlängenbereich konvertiert, so daß als Mischfarbe weißes Licht entsteht. Die gestrichelte Linie 30 in Figur 8 stellt ein Emissionsspektrum von einem erfindungsgemäßen Halbleiterbauelement dar, das Strahlung aus zwei komplementären Wellenlängenbereichen (Blau 25 und Gelb) und damit insgesamt weißes Licht aussendet. Das Emissionsspektrum weist hier bei Wellenlängen zwischen ca. 400 und ca. 430 nm (Blau) und zwischen ca. 550 und ca. 580 nm (Gelb) je ein Maximum auf. Die durchgezogene Linie 31 repräsentiert das Emissionsspektrum eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements, das die Farbe Weiß aus drei Wellenlängenbereichen (additives Farbtripel aus Blau, Grün und Rot) mischt. Das Emissionsspektrum weist hier beispielsweise bei den Wellenlängen von ca. 430 nm (Blau), ca. 500 nm (Grün) und ca. 615 nm (Rot)

je ein Maximum auf.

24

Desweiteren ist in Figur 11 ein Emissionsspektrum eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements dargestellt, das mischfarbiges Licht aus blauem Licht (Maximum bei einer Wellenlänge von ca. 470 nm) und rotem Licht (Maximum bei einer Wellenlänge von ca. 620 nm) abstrahlt. Der Gesamtfarbeindruck des abgestrahlten Lichtes für das menschliche Auge ist Magenta. Das vom Halbleiterkörper abgestrahlte Emissionsspektrum entspricht hier wiederum dem von Figur 7.

10

15

20

25

Figur 12 zeigt ein Weiß leuchtendes erfindungsgemäßes Halbleiterbauelement, das mit einem ein Emissions-Spektrum gemeäß Fiqur 7 aussendenden Halbleiterkörper versehen ist und bei dem als Leuchtstoff YAG:Ce verwendet ist. Von der vom Halbeiterkörper ausgesandten Strahlung nach Figur 7 wird nur ein Teil in einen längerwelligen Wellenlängenbereich konvertiert, so daß als Mischfarbe weißes Licht entsteht. Die verschiedenartig gestrichelten Linien 30 bis 33 von Figur 8 stellen Emissionsspektren von erfindungsgemäßen Halbleiterbauelementen dar, bei denen das Lumineszenzkonversionselement, in diesem Fall eine Lumineszenzkonversionsumhüllung aus Epoxidharz, unterschiedliche YAG: Ce-Konzentrationen aufweist. Jedes Emissionsspektrum weist zwischen $\lambda = 420$ nm und $\lambda = 430$ nm; also im blauen Spektralbereich, und zwischen $\lambda = 520$ nm und $\lambda = 545$ nm, also im grünen Spektralbereich, jeweils ein Intensitätsmaximum auf, wobei die Emissionsbanden mit dem längerwelligen Intensitätsmaximum zu einem großen Teil im gelben Spektralbereich liegen. Das Diagramm von Figur 12 verdeutlicht, daß bei dem erfindungsgemäßen Halbleiterbauelement auf einfache Weise durch Veränderung der 30 Leuchtstoffkonzentration im Epoxidharz der CIE-Farbort des weißen Lichtes verändert werden kann.

Weiterhin ist es möglich, anorganische Leuchtstoffe auf Basis von Ce-dotierten Granaten, Thiogallaten, Erdalkali-Sulfiden und

Contract Contract of the

25

Aluminaten direkt auf den Halbleiterkörper aufzubringen, ohne sie in Epoxidharz oder Glas zu dispergieren.

Ein weiterer besonderer Vorteil der oben genannten anorganischen Leuchtstoffe ergibt sich daraus, daß die Leuchtstoffkonzentration z.B. im Epoxidharz nicht wie bei organischen Farbstoffen durch die Löslichkeit begrenzt wird. Dadurch sind keine großen Dicken von Lumineszenzkonversionselementen nötig.

Die Erläuterung des erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements anhand der oben beschriebenen Ausführungsbeispiele ist natürlich nicht als Beschränkung der Erfindung auf diese zu betrachten. Als Halbleiterkörper, wie beispielsweise Leuchtdioden-Chips oder Laserdioden-Chips, ist beispielsweise auch eine Polymer
LED zu verstehen, die ein enstprechendes Strahlungsspektrum aussendet.

Patentansprüche

- 1. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterkörper (1), der im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische Strahlung aussendet, mit mindestens einem ersten und mindestens einem zweiten elektrischen Anschluß (2, 3), die mit dem Halbleiterkörper (1) elektrisch leitend verbunden sind, und mit einem Lumineszenzkonversionselement, das mindestens einen Leuchtstoff aufweist, 10 dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (1) eine Halbleiterschichtenfolge (7) aufweist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische Strahlung eines ersten Wellenlängenbe-15 reiches aus dem ultravioletten, blauen und/oder grünen Spektralbereich auszusenden, daß das Lumineszenzkonversionselement eine aus dem ersten Wellenlängenbereich stammende Strahlung in Strahlung eines vom ersten verschiedenen zweiten Wellenlängenbereiches umwandelt, 20 derart, daß das Halbleiterbauelement Mischstrahlung, bestehend aus Strahlung des ersten Wellenlängenbereiches und Strahlung des zweiten Wellenlängenbereiches aussendet.
- Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs in Strahlung mehrerer zweiter Wellenlängenbereiche aus voneinander verschiedenen spektralen Teilbereichen umwandelt, derart, daß das Halbleiterbauelement Mischstrahlung, bestehend aus Strahlung des ersten Wellenlängenbereiches und Strahlung der zweiten Wellenlängenbereiche aussendet.
- 3. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement in Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterbauele-

27

ments gesehen im Wesentlichen dem Halbleiterkörper (1) nachgeordnet ist.

- 4. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Lumineszenzkonversionselement über oder auf dem Halbleiterkörper (1) mindestens eine Lumineszenzkonversionsschicht (4) vorgesehen ist.
- 5. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Lumineszenzkonversionselement eine Lumineszenzkonversionsumhüllung (5) vorgesehen ist, die zumindest einen Teil des Halbleiterkörpers (1) und Teilbereiche der elektrischen Anschlüsse (2, 3) umschließt.
 - 6. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der bzw. die zweiten Wellenlängenbereiche zumindest teilweise größere Wellenlängen λ aufweisen, als der erste Wellenlängenbereich.

- 7. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der
 25. Halbleiterkörper (1) im Betrieb des Halbleiterbauelements ultraviolette Strahlung aussendet und daß das Lumineszenzkonversionselement zumindest einen Teil dieser ultravioletten Strahlung in sichtbares Licht umwandelt.
- 8. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Wellenlängenbereich und der zweite Wellenlängenbereich der Mischstrahlung zumindest teilweise in zueinander komplementärfarbigen Spektralbereichen liegen, so daß weißes Licht erzeugt wird.

15

- 9. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 2 oder nach Anspruch 2 in Verbindung mit einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der vom Halbleiterkörper ausgesandte erste Wellenlängenbereich und zwei zweite Wellenlängenbereiche ein additives Farbtripel ergeben, derart, daß in Betrieb des Halbleiterbauelements von diesem weißes Licht abgestrahlt wird.
- 10 10. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die vom Halbleiterkörper (1) ausgesandte Strahlung im blauen Spektralbereich bei λ = 430 nm oder bei λ = 450 nm ein Lumineszenz-Intentsitätsmaximum aufweist.
 - 11. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (1) in einer Ausnehmung (9) eines lichtundurchlässigen Grundgehäuses (8) angeordnet ist und daß die Ausnehmung (9) mit einer eine Lumineszenzkonversionsschicht (4) aufweisenden Abdeckschicht versehen ist.
- 12. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der
 25 Halbleiterkörper (1) in einer Ausnehmung (9) eines lichtundurchlässigen Grundgehäuses (8) angeordnet ist und daß die Ausnehmung (9) zumindest teilweise von dem Lumineszenzkonversionselement ausgefüllt ist.
- 13. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement mehrere Schichten mit unterschiedlichen Wellenlängenkonversionseigenschaften aufweist.

29

14. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement organische Farbstoffmoleküle in einer Kunststoff-Matrix aufweist, die insbesondere aus Silikon-, Thermoplast- oder Duroplastmaterial besteht.

15. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement organische Farbstoffmoleküle in einer Epoxidharz-Matrix aufweist.

10

20

25

- 16. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement organische Farbstoffmoleküle in einer Polymethyletacrylat-Matrix aufweist.
 - 17. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement (4,75) mindestens einen anorganischen Leuchtstoff (6) aus der Gruppe der Phosphore aufweist.

the state of the s

and the second second second

- 18. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß der anorganische Leuchtstoff aus der Gruppe der Ce-dotierten Granate ist.
- 19. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der anorganische Leuchtstoff YAG:Ce ist.
- 20. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der anorganische Leuchtstoff in einer Epoxidharz-Matrix eingebettet ist.

30

en grand de la companya de la compa

With the second second

en er eget eggen i de grande ger

21. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der anorganische Leuchtstoff in einer Matrix aus einem niedrigschmelzenden anorganischen Glas eingebettet ist.

5

22. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, daß der anorganische Leuchtstoff eine mittlere Partikelgröße von ca. 10 μ m aufweist.

10

23. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement mit mehreren verschiedenen organischen und/oder anorganischen Leuchtstoffen (6) versehen ist.

15

24. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement organische und/oder anorganische Farbstoffmoleküle mit und ohne Wellenlängenkonversionswirkung aufweist.

20

25. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement und/oder eine transparente Umhüllung (10, 15) lichtstreuende Partikel aufweist.

25

26. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement mit einem oder mehreren lumineszierenden 4f-metallorganischen Verbindungen versehen ist.

30

27. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß das Lumineszenzkonversionselement und/oder eine transparente Umhül-

The control of the second

31

lung (10, 15) mit mindestens einem im Blauen lumineszierenden Leuchtstoff versehen ist.

28. Verwendung einer Mehrzahl von lichtabstrahlenden Halbleiterbauelementen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 27 in einer vollfarbtauglichen LED-Anzeigevorrichtung.

5

10

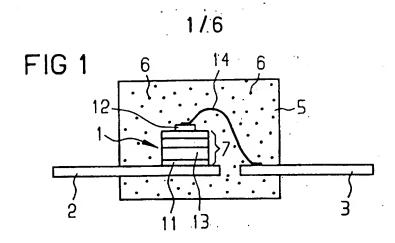
15

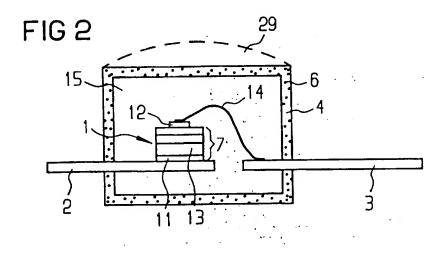
- 29. Verwendung einer Mehrzahl von lichtabstrahlenden Halbleiterbauelementen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 27 zur Innenraumbeleuchtung von Flugzeugkabinen.
 - 30. Verwendung eines lichtabstrahlenden Halbleiterbauelements gemäß einem der Ansprüche 1 bis 27 zur Beleuchtung von Anzeigevorrichtungen, insbesondere zur Beleuchtung von Flüssigkristallanzeigen.

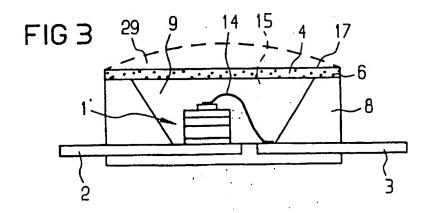
to the contract of the contract of

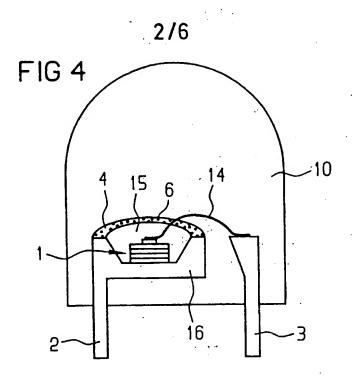
*

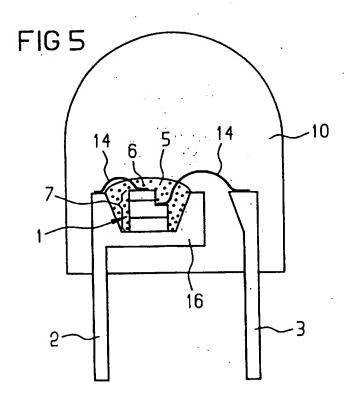
the transfer of the second

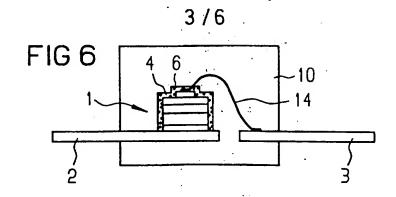


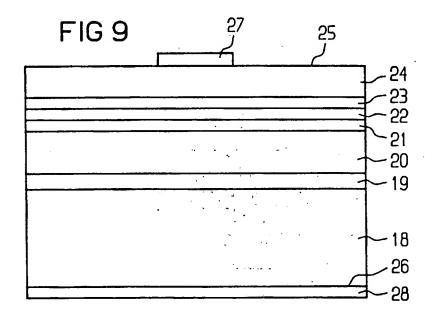


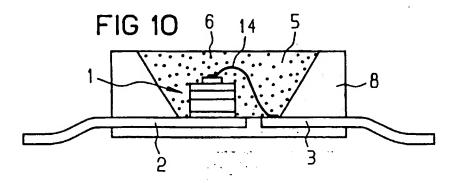


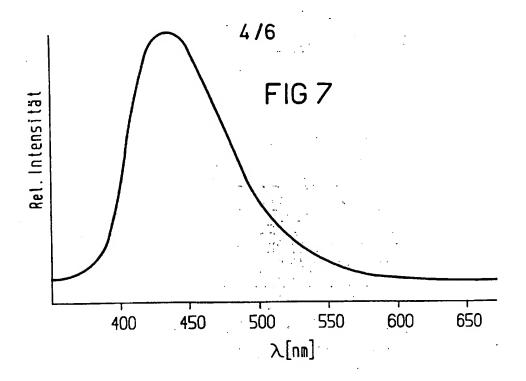


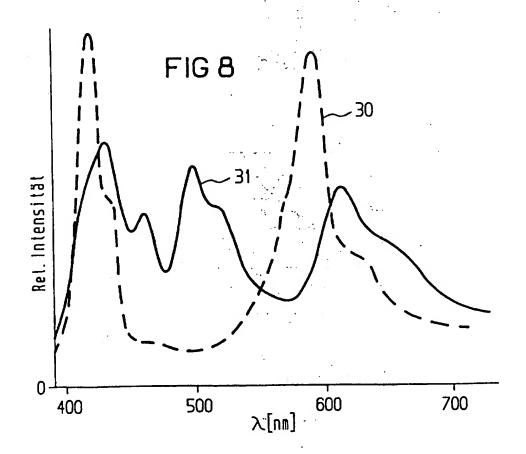


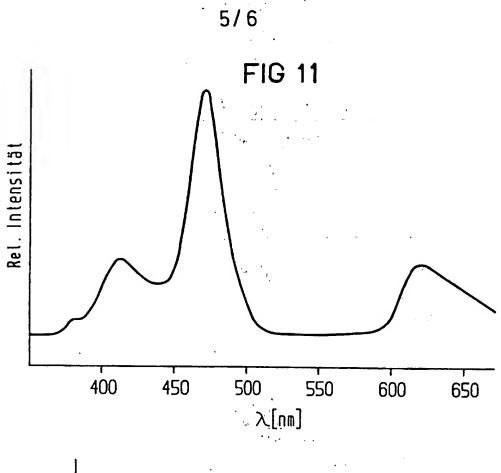


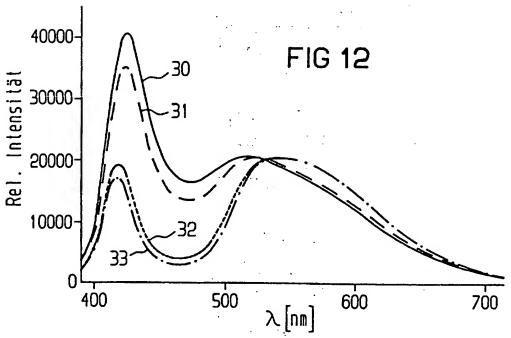




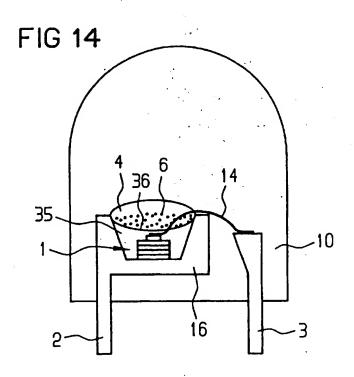








6/6
FIG 13
3 6 34 14 1 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. nai Application No PCT/DE 97/01337

		PCT/DE 97/0133/
A. CLASSII IPC 6	HO1L33/00 HO1S3/19	
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC	3
	SEARCHED	
	ourmentation searched (classification system followed by classification symbols) HOIL	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that such docume	nts are included in the fields searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data base and, wher	e practical, search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category "	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passag	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 542 (E-1441), 29 Septemb	1,5,10 er
	1993 & JP 05 152609 A (NICHIA CHEM IND LTD 18 June 1993, see abstract),
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 005, 31 May 1996 & JP 08 007614 A (NICHIA CHEM IND LTD 12 January 1996, see abstract	1,4,6,8, 10,30
A	DE 90 13 615 U (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) 6 December 19 see the whole document	5,6,14, 16,23
	-1	Alleria de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company
X Fur	her documents are listed in the continuation of box C.	atent family members are listed in annex.
"A" docum consi "E" earlier filing o "L" docum which citatic "O" docum other "P" docum	ant defining the general state of the art which is not disted dered to be of particular relevance invent document but published on or after the international date cannot be so that the publication date of another or document with the publication date of another or document extension or distered to establish the publication date of another or document referring to an oral disolosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but or provided the second of the prior to the international filing date but or document or document published prior to the international filing date but	nent of particular relevance; the claimed invention of be considered novel or cannot be considered to we an inventive step when the document is taken alone ient of particular relevance; the claimed invention of be considered to involve an inventive step when the ment is combined with one or more other such docu- ts, such combination being obvious to a person skilled
		of mailing of the international search report
2	29 September 1997	2 5. 10. 97
Name and	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	rized officer .
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	De Laere, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter and Application No
PCT/DE 97/01337

Category *	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages						Relevant to claim No.
	DE 33 CO1 3	15 675 A November	(OMRON 1983	TATEISI	ELECTRONICS		
	00, 0				,	• •	
					u *()		
						•	
							,
					• 1		
						**	
						~ .	
,		•		*			
							,
		-			• • • •		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					y Suria. Y Suria		
						•	
						•	
		,					
				•		•	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**	
					• .	•	
					• • •		
							1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

				97/01337	
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	•	Publication date	
DE 9013615 U	06-12-90	NONE			
DE 3315675 A	03-11-83	US 459953	7 A	08-07-86	
			٠.		
				•	
		9			
		5.27.29.			
		•	·	, .	

			•		
		*	•	•	
			·. ·	•	
				•	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tote onales Aktenzeichen PCT/DE 97/01337

	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L33/00 H01S3/19	
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und de	ar IPK
	RCHIERTE GEBIETE	
Recherchies IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H01L	
Recherohie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter	die recherchierten Gebiete fallen
	en de la companya de	and the same of th
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenb	oanx und evd. verwendete Suchbegnife)
C. ALRW	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie®		t kommenden Teile Betr, Amspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 542 (E-1441), 29.September 1993 & JP 05 152609 A (NICHIA CHEM IND LTD), 18.Juni 1993, siehe Zusammenfassung	1,5,10
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 005, 31.Mai 1996 & JP 08 007614 A (NICHIA CHEM IND LTD), 12.Januar 1996, siehe Zusammenfassung	1,4,6,8,
A	DE 90 13 615 U (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) 6.Dezember 1990 siehe das ganze Dokument	
	ikere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Inshmen	Anhang Patentiamilie
*Beaondei *A* Veröffe aber *E* älteres Ammi *L* Veröffe solle ausg *O' Veröff einse *P* Veröff dem	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Boldument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedzium veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- einen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ens im Reokerchenbericht genannten Veröffentlichungsdatum einer einen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ens im Reokerchenbericht genannten Veröffentlichungs beiegt werden eiden die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie werden, w Veröffentlic kann nicht werden, w Veröffentlic kenn nicht werden, w Veröffentlic diese Verit "A" Veröffentlich "Armektum "X" Veröffentlich kann nicht werden, w Veröffentlich kenn nicht werden, w Veröffentlich "A" Veröffentlich "X" Veröffentlich kenn nicht werden, w	röffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der g nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der zugnundelisgenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden ngegeben ist shung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun naufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf sher Tätigkeit beruhend betrachtet werden shung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun tals auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet renn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen ichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und bindung für einen Fachmann nahellegend ist chung, die Möglied derselben Petentfamilie ist latum des internationalen Recherchenberichts
	Absended 29. September 1997	2 5. 10. 97
Name und	Europáisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	htigter Bediensteter

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte phales Aktenzeichen
PCT/DE 97/01337

parametring our veronantichung, sowar emordenich unter	Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspru	ch Nr.
DE 33 15 675 A (OMRON TATEISI CO) 3.November 1983	ELECTRONICS	
	•	
	* 1.17:	
		•

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nales Aktenzeichen

Im Recherchenbericht Datum der · Mitglied(er)			,	97/01337 Datum der	
im Hecherchenbericht igeführtes Patentdokument	Veröffentlichung	Patentfamilie		Veröffentlichung	
DE 9013615 U	06-12-90	KEINE			
DE 3315675 A	03-11-83	US 4599537	' A	08-07-86	
•			•		
		•			
		•			
	·			•	
	•	;			
•		12 m			
		161	•		
			•		
	•		,		
			•		
	•				
		·			
		W .			
		(0)	:		